



Date d'édition : 17.04.2026

Ref : 578772

Transistor à effet de champ J112

Transistor à effet de champ pour la réalisation d'expériences de base dans le domaine de l'électronique.

Caractéristiques techniques:

- FET à canal N
- Puissance dissipée : max. 625 mW
- Applications : étages d'entrée à haute impédance

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Électricité/Électronique > Électricité/électronique (STE) > Transistors STE